

SOT89 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

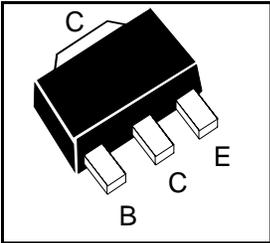
FCX458

ISSUE 3 – OCTOBER 1995

FEATURES

- * 400 Volt V_{CE0}
- * $P_{tot} = 1$ Watt

COMPLEMENTARY TYPE – FCX558
PARTMARKING DETAIL – N58



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	I_C	225	mA
Peak Pulse Current	I_{CM}	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	400		V	$I_C = 100\mu\text{A}$
	$V_{CEO(sus)}$	400		V	$I_C = 10\text{mA}^*$
	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Currents	I_{CBO}		100	nA	$V_{CB} = 320\text{V}$
	I_{CES}		100	nA	$V_{CE} = 320\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		100	nA	$V_{EB} = 4\text{V}$
Emitter Saturation Voltages	$V_{CE(sat)}$		0.2 0.5	V V	$I_C = 20\text{mA}, I_B = 2\text{mA}^*$ $I_C = 50\text{mA}, I_B = 6\text{mA}^*$
	$V_{BE(sat)}$		0.9	V	$I_C = 50\text{mA}, I_B = 5\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.9	V	$I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	100 100 15	300		$I_C = 1\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}^*$ $I_C = 100\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}^{**}$
Transition Frequency	f_T	50		MHz	$I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 20\text{V}$ $f = 20\text{MHz}$
Collector-Base Breakdown Voltage	C_{obo}		5	pF	$V_{CB} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Switching times	t_{on}	135 Typical		ns	$I_C = 50\text{mA}, V_C = 100\text{V}$ $I_{B1} = 5\text{mA}, I_{B2} = -10\text{mA}$
	t_{off}	2260 Typical		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device
For typical characteristics graphs see FMMT458 datasheet



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.